

# 2SA641

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ(アルミナパシベーション形)／

PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR(Alumina Passivation)

低周波高利得増幅用／Audio Frequency High Gain Amplifier

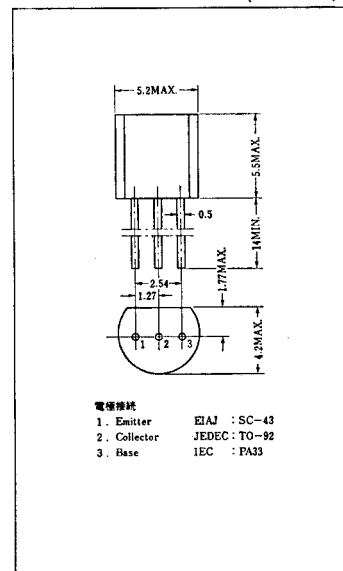
外形図／PACKAGE DIMENSIONS  
(Unit:mm)

## 特 徴／FEATURES

- ・低周波における高利得増幅用として最適です。
- ・直流電流増幅率が大きい。 $h_{FE} : 300\text{TYP.}$  ( $I_C = -0.5\text{mA}$ )
- ・2SC923 とコンプリメンタリで使える。
- ・High  $h_{FE}$   $h_{FE} = 300\text{TYP.}$  at  $I_C = -0.5\text{mA}$
- ・Complementary to NPN 2SC923.

絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-50	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-45	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5.0	V
コレクタ電流	$I_C$	-30	mA
全損失	$P_T$	250	mW
ジャンクション温度	$T_j$	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +125	$^\circ\text{C}$

電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -40\text{V}, I_E = 0$			-100	nA
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -3.0\text{V}, I_C = 0$			-100	nA
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE} = -3.0\text{V}, I_C = -100\mu\text{A}$	80	280		
直流電流増幅率	$h_{FE2}$	$V_{CE} = -3.0\text{V}, I_C = -0.5\text{mA}$	150	300	1000	
直流ベース電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = -3.0\text{V}, I_C = -0.5\text{mA}$		-0.63	-0.70	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -20\text{mA}, I_E = -2.0\text{mA}$		-0.20	-0.30	V
利得帯域幅積	$f_T$	$V_{CE} = -6.0\text{V}, I_E = 1.0\text{mA}$		100		MHz
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -6.0\text{V}, I_E = 0, f = 1.0\text{MHz}$		8.0		pF

 $h_{FE}$  区分/ $h_{FE}$  Classification $h_{FE2}/H : 150 \sim 300$  F : 225 ~ 450 E : 350 ~ 700 U : 500 ~ 1000